



# 「SiC MOS 界面の理解」

◇ 日時: 2018年12月17日(月) 13:00~17:30

◇ 場所: 筑波大学 東京キャンパス文京校舎 134 講義室、東京都文京区大塚 3-29-1  
(丸ノ内線茗荷谷駅下車 徒歩5分、[http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo\\_access.html](http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html))

SiCデバイス開発の最重要テーマの一つであるMOS界面は、近年大きな進展が見られているものの、依然として未解明な部分が多い。デバイス動作(チャンネル移動度、しきい値電圧など)や信頼性(しきい値電圧変動、酸化膜破壊など)に影響を与える界面欠陥の起源について幾つかの候補が挙げられているが、まだその理解は不十分である。デバイス・プロセスの研究者と界面の物理分析や第一原理計算の研究者が集まり、SiC MOS界面はどこまで理解できているか、また理解を深めるためには何をすべきかについて、各講師による講演を通して議論する。

.....プログラム.....

開会のあいさつ 13:00~13:05

大谷 昇 (関西学院大学、分科会幹事長)

第一原理計算による SiC 酸化膜界面の伝導帯端の揺らぎ(仮) 13:05~13:40

松下 雄一郎 (東京工業大学)

SiC 表面酸化の素過程と酸化機構の理解(仮) 13:40~14:15

秋山 亨 (三重大学)

第一原理計算による SiC 界面酸化(窒化)反応機構の解明(仮) 14:15~14:50

大野 隆央 (物質・材料研究機構)

休憩 14:50~15:05

SiC MOS 界面における窒素の局所構造解析(仮) 15:05~15:40

森 大輔 (富士電機)

SiC m 面の表面構造とその熱処理による変化(仮) 15:40~16:15

田中 悟 (九州大学)

ホール効果測定による SiC-MOSFET のキャリア散乱機構の評価(仮) 16:15~16:50

畠山 哲夫 (富山県立大学)

SiC トレンチ MOSFET のキャリア散乱機構(仮) 16:50~17:25

朽木 克博(豊田中央研究所)

閉会のあいさつ 17:25~17:30

■参加受付: WEB 参加受付システム([ここ](#)をクリック\*)から参加登録をお願いします。12月7日(金)の登録状況でテキスト印刷部数を決定しますので、以後の登録ではテキストを当日お渡しできない可能性があります。

\*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai12.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費: (テキスト代・消費税込)当日会場にてお支払いください。

先進パワー半導体分科会会員\*\* 2,000 円、分科会学生会員 1,000 円、一般 4,000 円、一般学生 1,000 円

\*\*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

問合せ先:

- |                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 矢野 裕司 (筑波大学)      | TEL: 029-853-5781 | e-mail: yano.hiroshi.fn@u.tsukuba.ac.jp |
| 喜多 浩之 (東京大学)      | TEL: 03-5841-7164 | e-mail: kita@scio.t.u-tokyo.ac.jp       |
| 土方 泰斗 (埼玉大学)      | TEL: 048-858-3822 | e-mail: yasuto@opt.ees.saitama-u.ac.jp  |
| 細井 卓治 (大阪大学)      | TEL: 06-6879-7282 | e-mail: hosoi@mls.eng.osaka-u.ac.jp     |
| 五十嵐 周 (応用物理学会事務局) | TEL: 03-3828-7723 | e-mail: igarashi@jsap.or.jp             |